PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11113282 A

(43) Date of publication of application: 23 . 04 . 99

(51) Int. CI

H02P 6/08

(21) Application number: 09303295

(22) Date of filing: 30 . 09 . 97

(71) Applicant:

TEXAS INSTR INC <TI>

(72) Inventor:

MAGGIO KENNETH J ROLF LAGGERQUIST

(54) METHOD AND CIRCUIT FOR CONTROLLING SLEW RATE OF MOTOR COIL

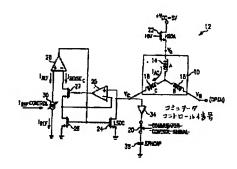
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a control circuit from being broken without increasing costs, complexity, and power consumption, by controlling a coil current of a stator coil winding of a multi-phase DC motor, and eliminating or reducing current and voltage spikes being generated during commutation.

SOLUTION: A stator coil winding 10 of a brushless DC motor performs Y-type connection and successively connect edge parts VA, VB, and VC of a coil A 14, a coil B 16, and a coil C 18 of a three-phase coil winding to a high- voltage side driver or a low-voltage side driver. Then, current flows from the coil A 14 to the coil C 18 after a high-voltage side commutation. And then, current flows from the coil A 14 to the coil B 16 due to a low-voltage side commutation. In this case, the low-voltage side commutation performs control so that the current of the coil B 16 increases from zero to a constant level as the current of the coil C 18 decreases to zero. Also, the high-voltage side commutation performs control so that the current at the coil A 14 decreases to zero and at the same time the current of

the coil C 18 increases to a steady level from zero.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-113282

(43)公開日 平成11年(1999) 4月23日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

H02P 6/08

H 0 2 P 6/02

371A

審査請求 未請求 請求項の数2 書面 (全 11 頁)

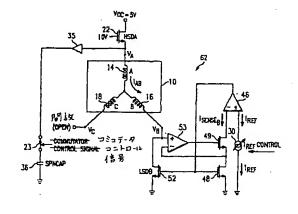
(21)出願番号	特願平9-303295	(71)出願人	590000879 テキサス インスツルメンツ インコーポ
(22)出顧日	平成9年(1997)9月30日	(72) 發明者	レイテツド アメリカ合衆国テキサス州グラス, ノース セントラルエクスプレスウエイ 13500 ケネス ジェイ, マッジオ
		(18/3697)	アメリカ合衆国テキサス州グラス, ピオー ルガード 8616, アパートメント ディ ー.
		(72)発明者	ロルフ ラガークイスト アメリカ合衆国テキサス州ダラス, サウス ウェスタンプールパード 8623, ナンパー 223
	•	(74)代理人	弁理士 浅村 皓 (外3名)

(54) 【発明の名称】 モータコイルのスリューレート制御方法および回路

(57)【要約】

【課題】多相DCモータのステータ巻線の電流スルーレートを制御して、転流動作中の電流および電圧スパイクを除去し、MOS回路等の破壌を防止するスルーレート制御回路を提供する。

【解決手段】第1定常状態制御回路(12)は高圧側転流後、A-Cコイル間の電流を規制する。Aコイル(14)は、一端が電圧源に結合され他端がセンタータップを介してCコイル(18)に結合される。低圧側転流回路(60)はC、Bコイル(16)の電流スルーレートを、Cコイルの電流がゼロに減少し、Bコイルの電流がゼロから定常状態レベルまで増大するよう制御して低圧側転流を行う。Bコイルの一端がセンタータップに結合する。第2定常状態制御回路(62)は低圧側転流後、A-Bコイル間の電流を規制する。高圧側転流回路(64)はC、Aコイルの電流スルーレートを、Aコイルの電流がゼロに減少しCコイルの電流がゼロから定常状態レベルへ増大するよう制御して高圧側転流を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 多相DCモータのコイルにおけるスルー レートを制御するにあたり、高圧側転流を実行するステ ップと;第1コイル中の第1電流および第2コイル中の 第2電流を規制するステップと;これら第1コイルおよ び第2コイルは第1端部と第2端部とを有し、これら第 1端部をセンタータップに結合し、この第1コイルの第 2端部を電流を供給する第1コイル高圧側ドライバに結 合し、およびこの第2コイルの第2端部を、前記電流を 規制する第2コイル低圧側ドライバに結合し;前記第2 10 一夕(固定子)巻線、即ちコイルに供給する電流を介し コイル中の第2電流を減少させることによって低圧側転 流を実行する一方、これに対応して、第3コイルに第3 電流を増加させるステップと;この第3コイルには、前 記センタータップに結合された第1端部と、前記第3電 流を規制する第3コイル低圧側ドライバに結合された第 2端部とを有し、この第2電流をゼロへ減少させ、ここ で第1電流はこの第3電流と等価なものとなり;前記第 3電流を規制するステップと;前記第1コイルの第1電 流を減少させることによって髙圧側転流を実行する一 方、これに対応して、前記第2コイルの第2電流を増加 20 させるステップとを具備し;前記第2コイルの第2端部 を、電流、供給用第2コイル高圧側ドライバに結合し、 前記第1電流をゼロに減少させ、ここでこの第2電流が 前記第3電流に等しいものである、コイルのスルーレー ト制御方法。

【請求項2】 3相DCモータのコイルにおけるスルー レートを制御するに当り、これらコイルの各々は、第1 端部と第2端部とを有し、各コイルの第1端部をセンタ ータップに結合する制御回路において、

高圧側転流の後に、第1コイルと第2コイルを通過する 30 電流を規制するように作動する第1定常状態制御回路 と;この第1コイルの第2端部を第1の高圧側ドライバ に結合すると共に、この第2コイルの第2端部を第2の 低圧側ドライバに結合し;前記第2コイルを通過する電 流を減少させることによって低圧側転流を実行し、これ と同時に、第3コイルを通過する電流を規定されたレー トで増大させるように作動する低圧側転流回路と;およ[・] びこの低圧側転流の後に、前記第1および第3コイルを 通過する電流を規制するように作動する第2定常状態制 御回路とを具備し;この第1コイルの第2端部を前記第 40 1 高圧側ドライバに結合すると共に、この第3コイルの 第2端部を第3低圧側ドライバに結合した3相DCモー タのコイルのスルーレート制御回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、概して、制御回路 の分野に関し、特に、多相DCモータのスルーレート (slew rate)の制御方法および制御回路に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】回転動作を与える多相直流 (DC) モー 夕には多種の応用例が存在している。特に、ハードディ スクドライブやCD-ROMドライブ等の応用例には、 例えば、3相DCモータ等の多相DCモータを利用し て、ハードディスクドライブの磁気ディスクを包含した 情報プラター (platter) を回転させている。こ れら情報プラターの回転速度の制御は、応用例全体の性 能に対して決定的なものとなる。

【0003】これら多相DCモータの回転速度は、ステ て制御されている。例えば、3相DCモータのステータ 巻線を、"Y"型結線すると共に、中央タップノードの 一端に結線されたAコイル、BコイルおよびCコイルが このステータ巻線に包含されている。各コイルの残余の 端部が、高圧側ドライバー、低圧側ドライバー、または 開放回路に選択的に結合された、転流が行なわれるよう になる。この時間中、第3コイルは一端上の中央タイプ に結合される一方、他端は、開放回路として設けらてい る。所定期間後に、転流 (コミュテーション) が起るの で、電流が、この第3コイルを介して流れることができ ると共に、第1コイルまたは第2コイルを介して流れる ことができる。この転流とは、回路中の一通路から、他 の通路に電流が転送されることである。この結果とし て、転流が起るまでの定常状態動作中に、これら3個の コイルの中の2つのコイルを介して電流が流れ、この転 流時に、次の転流が起るまで、2つのコイルおよび第3 コイルの1つのコイルを介して電流が流れる。

【0004】全体として6種の電流が、6回の転流を経 て3相DCモータのステータ巻線中に供給できるように なっている。例えば、以下の順序でステータコイルに電 流が供給されることによって、3相DCモータのロータ (回転子) に対して、回転動作が分配される:即ち、A コイルからCコイルへ、AコイルからBコイルへ、Cコ イルからBコイルへ、CコイルからAコイルへ、Bコイ ルからAコイルへ、およびBコイルからCコイルへ分配 される。

【0005】ステータ巻線のこれらコイル中に、電流を 転流させる場合に、問題が生じる。即ち、転流の結果と して、電流および電圧スパイクが発生することである。 電流が一個のコイル中に減少すると共に、他のコイル中 で増大する場合に、これら電流および電圧スパイクが起 る。これら電流および電圧スパイクによって、感度制御 回路にダメージを与えてしまう。例えば、金属酸化物半 導体 (MOS) 回路のような電圧感応回路は、ブレーク ダウン (降伏) 電圧が印加された場合に、破壊すること がある。これら電流および電圧スパイクによって、転流 中に発生した電圧スパイクより大きなブレークダウン電 圧を有する制御回路内においては集積回路技術およびト ランジスタ技術を駆使する必要がある。この結果、より 50 大型の制御回路となってしまい、これによって、回路規 模が増大すると共に、電流消費が増大してしまうように なる。

【0006】更にまた、外部ツエナーダイオードのよう な追加の回路を、この制御回路中に設ける必要があり、 これによって、電流または電圧スパイクによって、プレ ークダウン電圧レベルを超過するような場合において、 この制御回路がダメージを受けないように防止する。こ のことによって、更に、制御回路全体のコスト、複雑 度、および電力消費が増大するようになる。また、外部 ツエナーダイオードが故障した時に、この制御回路が破 10 壊してしまうので、システム全体の信頼性が損なわれて しまうようになる。

【0007】また、別の問題が、ステータ巻線内の転流 中に発生した電圧/電流スパイクの存在によって起る。 電流/電圧スパイクによって、トルクリップルが生じて しまい、ならびに共振周波数が生じてしまう。この結果 として、2~4 k H z 範囲の可聴ノイズが生じてしま い、これは、代表的な転流周波数である。このトルクリ ップル中に、データを読取ることによってデータエラー が生じて、ハードディスクドライブ全体の性能に悪影響 20 が与えられてしまう。

[8000]

【発明が解決しようとする課題および解決するための手 段】以上のことから、以下の要望が明らかになる。即 ち、スルーレートを制御できる回路および方法におい て、多相DCモータのステータ巻線のコイル中の電流を 制御して、転流中に発生する電流および電圧スパイクを 除去または減少させる回路および方法を要望されてい る。本発明によれば、多相DCモータのスルーレートを 制御できる回路および方法が提供され、これによって、 30 2を表わし、高圧側転流の後に設置すると共に、この制 電流および電圧スパイクを制御および除去でき、また、 前述した欠点や問題点を、実質的に除去することができ る。

【0009】また、本発明によれば、例えば、多相DC モータ中のコイルの電流スルーレートのようなスルーレ ートを制御する方法が提供でき、これには、高圧側転移 が実行されると共に、第1コイル中の第1電流および第 2コイル中の第2電流を規制 (regulate) する 方法が包含されている。これら第1コイルと第2コイル とを、センタータップて互いに結合する一方、この第1 40 コイルの対向端部と、電流供給用の第1コイル高圧側ド ライバに結合すると共に、第2コイルの対向端部を、こ れら第1コイルおよび第2コイル中の電流を規制する第 2コイル低圧側ドライバに結合する。

【0010】更に、この方法には、第2コイル中の第2 電流を減少させることによって、低圧側転流を実行する 一方、これに対応して、第3コイルを通る第3電流を増 大させ、この第3コイルを、センタータップと、この第 3電流を規制するための第3コイル低圧側ドライバとの

した結果として、最終的に、この第2電流をゼロまで減 少させると共に、次に、第1電流を、第3電流に等しく させる。また、この方法には、第3電流を規定すると共 に、高圧側転流を実行する手法が包含されている。この 高圧側転流は、第1コイル中に流れる第1電流を減少さ せることによって実行される一方、これに対応して、第 2コイル中の第2電流を増加させ、他方、この第2コイ ルを、センタータップと、電流供給用の第2コイル高圧 側ドライバとの間に結合する。最終的に、この第1電流 は、ゼロまで減少されると共に、この第2電流は、第3 電流と等価なものとなる。

【0011】本発明によれば、種々の技術的な利益が得 られるようになる。即ち、本発明の一技術的利益によれ ば、多相DCモータのステータ巻線中の電流および電圧 スパイクを除去または、減少させることができる。この 結果として、例えば、5 Vのブレークダウン (降伏) 電 圧を有する0.8ミクロンの回路のような、低いスレッ シュホールド電圧を有する小型の回路を利用できるよう になる。また、このことによって、電力消費が低く抑制 できる。また、他の技術的利点としは、外部のツエナー ダイオードを除外できることである。また、更に、他の 技術的な利点としては、信頼性が向上したことである。 更に、本発明の技術的な利益としては、トルクリップル および共振周波数による可聴ノイズを除去または減少で きることである。その他の技術的利点は、当業者であれ ば、以下の図面、説明および請求項から、容易に理解で きるものである。

[0012]

【発明の実施の形態】図1は、第1定常状態制御回路1 御回路12によって第1状態が表わされている。この第 1定常状態制御回路12は、ブラッシュレスDCモータ のステータ (固定子) 巻線10に結合されて表わされて いる。このステータ巻線10は、Y型結線された3相巻 線であり、内部に、Aコイル14, Bコイル16, およ びCコイル18を包含している。これらAコイル14, Bコイル16, Cコイル18の各々は、第1端部および 第2端部を有している。これらコイルの各コイルの第1 端部を互いに結合して、ノードを構成し、このノードを センタータップと称する。また、これらコイルの各コイ ルの第2端部を結合して、例えば、第1定常状態制御回 路12のような回路をサポートするので、これらコイル 中の2つのコイルおよびセンタータップを介して、コミ ュテータ (図1では図示しない) によって決定される選 択されたインターバルで、電流が供給できる。

【0013】これらコイルの2つを介して、電流が流れ る場合に、2つのコイルの一方のコイルの第2端部が高 圧側として作用するのに対して、他方のコイルの第2端 部が低圧側として作用する。この低圧側は、2つのコイ 間に結合する方法が包含されている。低圧側転流を実行 50 ルを介して流れる電流を規制するように動作する。残り

のコイルの第2端部が、開放回路状態で設けられてい る。例えば、図1は以下のような状況を表わしている。 即ち、ノードVAにおいて、Aコイル14の第2端部が 高圧側として作用すると共に、高圧側ドライバA(HS DA) 22に結合されるので、電圧源Vccによって与 えられた電流が、Cコイル18を介して、ノードVcの それ自身の第2端部に供給できるようになる。このHS DA22は、例えば、スイッチとして作動するnチャネ ルMOSFETのようなパワーFETとして実現でき る。Cコイル18の第2端部は、低圧側として作用する 10 と共に、低圧側ドライバC (LSDC) 24に結合され る。このLSDC24は、例えば、飽和領域で作動する nチャネルMOSFETのようなパワーFETで実現で きる。即ち、このLSDC24を用いて、Aコイル14 とCコイル18に供給される電流 IAcを規制する。最 後に、Bコイル16の第2端部が、開放回路状態で図示 されている。ここで、本発明は、3相ステータを有する 3相DCモータを使用して実現しているが、本発明は、 この3相DCモータに限定されることなく、多相DCモ ータを利用して実現できる。

【0014】例えば、ステータ巻線10のような3相巻 線を用いる場合には、6組の電流の流れの組合せの可能 性がある。Aコイル14、Bコイル、Cコイル18の第 2端部の各々を、高圧側ドライバまたは低圧側ドライバ に結合できるので、電流は、いずれか2つのコイルを通 って流れることができると共に、予じめ決められたシー ケンスで決定されるいずれかの方向へ流れることができ る。例えば、電流は、ステータ巻線10のコイル中を、 以下の方法および順序で流れることができる。即ち、A コイル14からCコイル18へ; Aコイル14からBコ 30 イル16へ; Cコイル18からBコイル16へ; Cコイ ル18からAコイル14へ; Bコイル16からAコイル 14へ:およびBコイル16からCコイル18へ流れ る。3相DCモータの動作において、電流がステータ巻 線のコイル間から切換り、これによって磁気ロータ(図 1に図示せず) に回転力が与えられるように、これら6 組の電流の流れの各々が、設定されたシーケンスとして 確立される。一般に、6組の電流の流れの設定されたシ ーケンスは、高圧側転流が起った後に、次のシーケンス が、高圧側転流によって追従された低圧側転流となるよ 40 うに進行する。例えば、Aコイル14からCコイル18 への電流の流れが、高圧側転流の後に行われ、次に、こ れは、低圧側転流によって追従されて、Aコイル14か らBコイル16への電流の流れとなる。このような場合 では、Bコイル16の第2端部が、それの低圧側ドライ バに結合されるので、Aコイル14からBコイル16へ の電流の流れを確立すると共に、規定する。このような 状態のシーケンスを、図1、2、3に図示する。低圧側 転流が起り、定常状態に到達した後で、次に、高圧側転 流が起る。例えば、高圧側転流がAコイル14からCコ 50 。。n.ο 電流を発生する。この電流は、電流 🛚 🗛 C

イル18へ起るので、Cコイル18からBコイル16へ 電流の流れが確立されるようになる。このような状態、 即ち転移を図4に示す。

【0015】図1において、第1定常状態コントロール 回路12は、髙圧側転流によって第1状態が規定された 後、ステータ巻線10に結合される。この第1定常状態 コントロール回路12によってAコイル14からCコイ ル18へ定常状態ステータ電流 IAcが供給される。こ の第1定常状態コントロール回路12には、高圧側部お よび低圧側部が設けられている。この高圧側部にはHS DA22が設けられている。この低圧側部には、LSD C24、センスFET C26、増幅器25とFET2 7とを包含したボルテージフォロア、基準増幅器28、 基準電流コントロール信号によって制御される基準電流 源30、サンプル増幅器34、コンデンサスイッチ2 0、およびスピンドルコンデンサ36が設けられてい

【0016】最初に、高圧側転流が起った後に、スイッ チとして作動するHSDA22が、10Vをそのゲート 20 に印加することによって、ONとなる。このゲート電圧 は、チャージポンプを利用して、電圧源によって供給さ れた10V電源とすることができる。この時、電圧V ccによる電流が、HSDA22のソースを経てこれの ドレインに与えられると共に、ノードVAにおけるAコ イル14の第2端部に供給されるようになる。

【0017】飽和領域内を動作している間に、LSDC 24を用いて、HSDA22からAコイル14およびC コイル18へ供給された電流を規制する。また、このL SDC24を用いて、Bコイルの第2端部に結合された 高圧側ドライバ (図1には図示されず) を利用して、B コイル16からCコイル18へ電流が供給される場合 に、この電流を規制する。LSDC24のゲート・ソー ス電圧を、基準増幅器28の出力によって制御する。こ の基準増幅器28には、Ic電流入力端と、 IREF電流入力端とが設けられている。IREFは、 基準電流コントロール信号によって制御されるように、 基準電流源30により発生される。この基準電流信号 は、第1定常状態コントロール回路12の外部に設けた コントロール回路によって供給される。一般に、基準電 流コントロール信号は、特定の状態の下で、基準電流源 30によって一定電流 IREFが供給されるように供給 されている。しかし乍ら、この基準電流コントロール信 号を変化させることによって、「REFを可変でき、こ れによって、IACが種々のレベルで提供できるように なる。基準増幅器28によって、 IREFと Ieとの間の差を検知すると共に、LSDC2

4のゲートをコントロールするために用いられる対応の 出力信号を発生する。

【0018】センスFET C26を用いて、I

の大きさを変更したものである。これらセンスFET C26、LSDC24、増幅器25およびFET27 を、カレントミラー (電流ミラー) として、構成するこ とによって、I.on.ocは、IAcに比例するよう になる。このカレントミラーは、センスFET C26 のソースとゲートと、LSDC24とを結合することに よって構成される。ドレインを、増幅器25とFET2 7とを有する電圧フォロアを介して結合する。この電圧 フォロアによって、センスFET C26のドレインに おけるノードVcに電圧を供給して、このカレントミラ 10 ーを有効的にカスコードする。また、この増幅器25 は、FET27のゲイン電圧を調整する、ゲイン1のバ ッファとすることができるので、ノードVcにおける電 圧を、センスFET C26のドレインに設ける。また この増幅器25によって、ノードVcから全く、または 極めて制限された電流が導出され、この結果として、あ らゆる回路効果を減少させ、電圧フォロアおよび他の結 合された回路は、LSDC24の動作およびステータ巻 線10の動作を保持することができる。また、他の実施 ることもでき、このカスコードデバイスによって、電流 およびバイアス条件の広範囲に亘って、更に正確なⅠ ■ • n ■ • c を有する改良されたカレントミラーが得ら れる。

【0019】LSDC24およびセンスFET C26 を適切に設計することによって、発生させたI

。。。。。cが、IAcの変更した電流となる。このこ とは、LSDC24のチャネル幅が、センスFET C 26のチャネル幅よりかなり大きなものとなるように確 保することによって実現される。

【0020】基準増幅器28によって、IREFとIcとを比較して、これに対応した差、即ち、 エラー信号を発生する。また、この基準増幅器28によ って、IREFの値からI.....の値を減算し、 この差に、対応するゲインを掛算してその出力信号を発 生する。この出力信号が、センスFET C26のゲー トと、LSDC24に供給される。このゲート電圧を印 加することによって、基準増幅器28は、IACを制御 - する。これは、LSDC24のゲート・ソース電圧を調 整することにより行われ、この電圧を利用して、IAC 40 この結果として、ISSNISCは、この電流が I を規制する。一旦、定常状態になると、基準増幅器28 の出力が一定値に到達する必要があり、従って、LSD C24のゲート・ソース電圧が一定レベルで維持される ようになる。この結果として、基準増幅器28によっ て、LSDC24のゲート電圧を調整するので、この結 果として、Aコイル14とCコイル18を経て流れる電 流が、IREFに比例、即ち、関連するようになる。

【0021】電流がAコイル14とCコイル18を経て 流れている間に、スピンドルコンデンサ36は、ノード VcのCコイル18の第2端部に結合するので、その結 50 たように、第1状態から第2状態へ切換えられる。この

果として、このスピンドルコンデンサ36は電圧Vcま で充電される。このスピンドルコンデンサ36は、サン プル増幅器34およびコンデンサスイッチ20を介して Cコイルの第2端部へ結合する。このサンプル増幅器3 4は、バッファ、またはアイソレーション(隔離)増幅 器として機能して、この結果、このスピンドルコンデン サ36による他の回路への影響を隔離する。 コンデンサ スイッチ20が閉鎖位置に設けられ、コミュテータ (転 流器) コントロール信号によって制御されるようになっ ている。このコミュテータコントロール信号は、第1定 常状態コントロール回路12の外部への回路によって供

給されると共に、センタータップとBコイル16の第2 端部との間に発生する送起電力 (BEMF) を測定する ことによって発生することができる。一実施例によれ ば、このコミュテータコントロール信号を、このBEM Fの状態に依存して、イネーブル状態で供給することが できる。この代りに、このコミュテータコントロール信 号は、タイマー回路を利用して発生することもできる。 コンデンサスイッチ20が閉鎖位置にある期間中、スピ

例ではこの増幅器25を、カスコードデバイスで構成す 20 ンドルコンデンサ36を利用して、低圧側の電圧、即 ち、C-コイル18の第2端部における電圧をサンプリ ングする。

【0022】動作において、第1定常状態コントロール 回路12によって、電流 IAcが供給されると共に、規 制される。ゲート電圧がHSDA22に供給され、これ によって、例えば、5V電源から供給されるようなV ccから、電流がHSDA22を介して、ノードVaへ 供給できるようになる。次に、この電流は、Aコイル1 4、Cコイル18を経て、LSDC24まで流れるよう 30 になる。LSDC24は、これのゲート・ソース電圧を 規制する基準増幅器28からの出力信号を受信すること によって、 IAcを規制する。 基準増幅器 28によっ て、IACのスケールダウンした電流値(Icとして表示)と、IREFとを比較すると

共に、これら2つの電流間の差に相当する出力を発生す る。このIェ・nェ・cがIREFより小さい場合に は、更に、正の出力信号がLSDC24のゲートに供給 され、これによって、LSDC24のゲート・ソース電 圧が上昇し、この結果、IAcが増大するようになる。 REFと等しくなる時間まで、増大するようになる。 I **∞・n・・**cが I REFより大きい場合には、基準増幅 器28によって、余り正極性でない出力信号が発生し て、これによって、LSDC24のゲート・ソース電圧 が低下する。この結果として、減少したIAcとI

。。n。。cとが得られるようになる。スピンドルコン デンサ36がノードVc間に設けられ、その電圧まで充 置される。

【0023】所定時間経過後、この回路は、図1に示し

第1状態では、定常状態電流が、HSDA22、Aコイ ル14、Cコイル18およびLSDC24を介して供給 され、この第2状態では、図2に示したように、電流が、 HSDA22、Aコイル14、Bコイル16および、B コイル16の第2端部に結合された低圧側ドライバを介。 して供給される。この転移を、低圧側転流と称し、これ については、図2を参照し乍ら、更に詳述するものとす る。第1状態から第2状態への転移中に、回路に損障を

【0024】図2は、第2状態を表わす低圧側転流回路 60を表わす回路図である。この第2状態では、ステー タ巻線10によって、ノードVAからノードVcへの電 流供給が、ノードVAからノードVBへの電流供給へ転 流する。これを実現するために、この低圧側転流回路6 Oを用いて、以下の方法のように、Cコイル18とBコ イル16の電流スルーレート (slew rate)を 制御している。即ち、Cコイル18中の電流がゼロに減 少すると共に、Bコイル16中の電流がゼロから定常状 態レベルへ増加するように制御する。このステータ巻線 20 10のコイルを経て流れる電流を、図5の第2状態とし て図示すると共に、更に、以下に詳述する。

与えたり、エラーの原因となる電圧スパイクを防止する

ことは重要なことである。

【0025】低圧側転流回路60には、種々の回路素子 が設けられている。これら素子を利用して、Cコイル1 8中の電流を、除々にまたは制御可能な状態で減少させ る一方、同時に、Bコイル16中の電流を除々に増大さ せ、この結果として、制御可能なスルーレートが得られ る。また、この低圧側転流回路60には、HSDA22 が設けられており、これを利用して、電圧源Vccから Aコイル14、Cコイル18、Bコイル16を経て電流 30 を供給する。

【0026】最初に、高圧側転流の後の定常状態動作中 に、スピンドルコンデンサ36に予じめ保存された電圧 Vcを、ホールド増幅器42の反転端子に供給する。こ のホールド増幅器42の非反転端子を、ノードVcとし て称しているCコイル18の第2端部に結合する。 更に また、定電流源44を、コンデンサスイッチ21を介し てスピンドルコンデンサ36に結合すると共に、充電電 流を供給して、このスピンドルコンデンサ36間の電圧 を更に増大する。このホールド増幅器42の出力を、L 40 し続けるので、電流Icは、このI.ensecに沿っ SDC24のゲートとセンスFET C26に供給する と共に、これらFETのゲート・ソース電圧を制御す る。従って、この定電流源44によってスピンドルコン デンサ36間の電圧を増大させるので、このホールド増 幅器42の出力が、更に減少した値で得られ、これによ って、更に、電流Icを、Cコイル18を介して減少さ せると共に、低圧側転流基準増幅器46に供給される電 T27は、電圧フォロアとして作用すると共に、上述の ように動作する。定電流源44によって供給された電流 50 ようにし、これによって、定常電流 I д в が A コイル 1

は、一定の電流源であるか、または、モータ速度または BEMFのようなモータの条件に依存した機能のよう な、所望の機能に従う電流源である。

【0027】低圧側転流基準増幅器46によって、低圧 側ドライバB (LSDB) 52のゲート・ソース電圧お よびセンスFET B48を制御する。LSDB52お よびセンスFET B48を、カレントミラー構成とし て、電流 I sensecを、Bコイル 16を通る電流 I вの減少した電流として発生するようにする。このこと 10 は、LSDB52チャネル幅を、センスFET B48 のチャネル幅よりかなり大きく確保することによって実 現できる。図2に示したように、電圧フォロアがLSD B53のドレインとセンスFET B48との間に設け る。また、増幅器53とFET49とが、LSDB53 のドレインとセンスFET B48との間の電圧フォロ アとして構成されて図示されている。低圧側転流基準増 幅器46によって、LSDB52のゲート・ソース電圧 とセンスFEB B48とを、電流IREFと、I ■ m m m c c 、 I m m m m m m b を比較することによっ て調整する。この電流IREFは、基準電流コントロー ル信号によって制御できるように、基準電流源30によ って発生される。ホールド増幅器42の出力によって制 御されるように、Iaanacが継続して減少するの

52のゲート・ソース電圧とセンスFET B48とを 増大させることによって、増加させる。このことによっ て、より多くの電流が、センスFET B48とLSD B52とを経て流れ得る。

で、低圧側転流基準増幅器46によって、電流 I

【0028】定電流源44によって、スピンドルコンデ ンサ36に電流が供給されるように、スピンドルコンデ ンサ36の電圧が増大し続けるので、このスピンドルコ ンデンサ36は、充電し続けるようになる。この期間 中、コミュテータコントロール信号によって制御される ようなコンデンサスイッチ21が閉鎖状態で得られる。 結局、このスピンドルコンデンサ36間の電圧は、電圧 Vcにほぼ等しい初期値から、LSDC24のゲート・ ソース電圧が、これのスレッシュホールド電圧より低く 低下するまでのような時間まで、いくらか線形的に上昇 て、ゼロまで減少するようになる。このことは、ゲート ・ソース電圧が約0.6 Vまたはこれ以下に到達した時 に起る。

【0029】図3は、第2定常状態コントロール回路6 2を示す回路図であり、このコントロール回路62は、 低圧側転流の後に設けられると共に、以下に説明するよ うに、図5で示した第3状態を表わす。この第2定常状 態コントロール回路62は、ノードVcからノードVB までの低圧側転流の後、ステータ巻線10に結合される

4とBコイル16とを経て供給されるようになる。 【0030】HSDA22を、Vccに依然として結合 させることによって、電流を、ノードVAのAコイル1 4の第2端部へ供給する。HSDA22によってノード VAに電流が供給される一方、第2定常状態コントロー ル回路62の追加の回路が、ノードVェでBコイルの第、 2端部を介して結合されて、電流 I д B を規制する。特 に、LSDB52とセンスFET B48とを、電圧フ ォロアを有するカレントミラー構成して、それらのドレ 3とFET49とが設けられている。

【0031】低圧側転流基準増幅器46によって、Ⅰ **n**BとIREFとを比較して、出力信号を発生 する。この出力信号を用いて、LSDB53のケード・ ソース電圧とセンスFET B48とをコントロールす る。この低圧側転流基準増幅器46によって、IREF の値を、基準電流器30と基準電流コントロール信号と を介して設定したように、比較して、 I REFが I 』。」。より大きな場合に、更に正の出力信号を発生 する。この結果、IABとIュ・カュ・Bとが増大する ようになる。IREFがI・・・・・・・・・おけい場合 には、この低圧側転流基準増幅器46によって、逆方向 の正の出力信号が発生され、この結果として、IABと I SENSEBとが小さくなくる。結局、この第2定常 状態コントロール回路62が、定常状態に収束するよう になる。

【0032】電流 I ABが、Aコイル14とBコイル1 6とを介して供給されている間に、スピンドルコンデン サ36は、コンデンサスイッチ23とサンプル増幅器3 5を介してノードV人に結合される。サンプル増幅器3 5は、バッファまたはアイソレーション増幅器として作 用して、スピンドルコンデンサ36による他の回路への 影響を隔離する。コンデンサスイッチ23が、コミュテ ータコントロール信号によって制御されるように閉鎖状 態で得られる。このような構成によって、スピンドルコ ンデンサ36によってストアされている電圧Vュが得ら

【0033】図4は、高圧側転流回路64を表わす回路 図であり、図5に示すように第4状態を表わしている。 この高圧側転流回路64を利用して、高圧側転流が実行 40 され、ここにおいて、Aコイル14は、高圧側として作 用する状態から、高圧側として作用するCコイル18へ 転移する。この結果として、電流「ムは、制御可能に減 少する一方、電流Icは、これに対応して、制御可能に 増大するようになる。上記第4状態として規定される高 圧側転流、または転移中に、ノードVBにおけるBコイ ル16の第2端部を介して結合された回路は、第3図に 関連して、上述したように、動作し続くと共に、低圧側 規制を実行することによって、これにより電流Ⅰョは、 Bコイル16を通って流れ続くようになる。

【0034】HSDA22のゲートを、ホールド増幅器 50の出力に結合する一方、このホールド増幅器50の 反転端子を、HSDA22のソースに直接結合する。ま た、このホールド増幅器50の非反転端子を、電流源7 2と、スピンドルコンデンサ36との間の並列接続の1 つのノードに結合する。コンデンサスイッチ29を、コ ミュテータコントロール信号によって制御できるよう に、閉鎖回路状態で設け、これによって、スピンドルコ ンデンサ36が、ホールド増幅器50の非反転端子に結 イン同志を結合する。この電圧フォロアには、増幅器5 10 合する。最初、このスピンドルコンデンサ36に電圧V ムが保持されており、この電圧を、電流源72に基因し て、スピンドルコンデンサ36間の電荷の欠乏によっ て、直線的に減少させる。

【0035】最初、HSDA22のゲートは、10Vの 電圧を保持している。この電圧を、多少、直線的に減少 させる。この直線状態は、電流源72に基因して、スピ ンドルコンデンサ36間の電圧降下に相当する。ホール ド増幅器50の出力が減少するので、電圧Vへもまた、 減少する結果、電流 I Aが減少する。電流源72を定電 流源として説明してきたが、この電流源72は、例え ば、モータスピードまたはBEMFのようなモータの状 態に依存したレートで提供することも可能である。これ は、予じめ規定された、または規定可能なレートとする こともできる。

【0036】ノードVAに結合した回路が電流IAを減 少させるように動作する一方、同時に、ノードVcに結 合した回路が、Cコイル18を経て電流Icを増大させ るように動作する。 高圧側ドライバC (HSDC) 6.6 を用いて、5 V電圧源 Vccから供給された電流を提供 する。このHSDC66は、10Vゲート電圧を受け、 この電圧によって、このHSDCがスイッチとして作動 できるようになり、この結果として、C-コイル18を 介して、ドレインからソースへ電流を流すことができ る。Aコイル14を通る電流IAが減少し続けるよう に、Cコイル18を通る電流Icが増加し続ける。ノー ドVBに結合した回路によって、Bコイル16を通る電 流Ⅰョを、ⅠムとⅠcの転移のように、規制し続ける。 従って、電流IAとIcとのスルーレートが制御される と共に、この電流は、所定のレートでステータ巻線10 を経て転移して、上述したマイナスの効果を除去するよ うになる。

【0037】図5は、Aコイル14のステータ電流 IA、Bコイル16のステータ電流IB、およびCコイ ル18のステータ電流 Icのタイミング線図である。ス テート (状態) 1は、図1の回路によって供給された電 流に対応し、ステート2は、図2の回路によって発生さ れた電流に対応する。また、ステート3は、図3に示し た回路によって供給または発生された電流に対応する一 方、ステート4は、図4の回路によって発生された電流 50 に対応する。

13

【0038】このタイミング線図から明らかなように、 高圧側転移の後の定常状態 (図1に表わされているよう に)中では、電流 I Aが、正の方向に、即ち、センター タップに向かって、ノードVAからおよびAコイル14 を経て流れるように図示されている。また、電流 I _が、センタータップから負の方向に、Cコイル18を 経てノードVェへ流れるように図示されている。ステー ト2は、制御可能なスルーレート、即ち、電流制御型低 圧側転移を表わし、ここでは、電流Ⅰョが、ゼロ、即 ち、開放状態レベルから、負の値に転移する。同時に、 電流Icが、それ自身の定常状態負の値から、ゼロレベ ルまで転移する。電流IAが正方向に保持される。ま た、低圧側コミュテーションを実行するための説明図 が、図2に図示されている。

【0039】ステート3は、低圧側コミュテーションの 後の定常状態動作を表わし、ここでは、IAが正のレベ ル、IBが負のレベル、およびIcがゼロレベルとして 表わされている。低圧側コミュテーションの後の定常状 態動作中に、IA、IB、Icを発生させるために用い られる説明図が、図3に表わされている。ステート4 は、高圧側コミュテーションを表わしており、ここで は、IAが、正方向に流れている状態から、遮断される 状態へ、転移する。また、Icは、遮断状態から正方向 へ流れる状態へ転移するのが表示されている。これから 明らかなように、これら転移は、同時に起っている。I pは一定の負の値で流れ続けている。

【0040】図5のステート2およびステート4に図示 したように、低圧側転流および高圧側転流中に、スルー レートを制御している。この図は、高圧側および低圧側 制御を図示しているが、本発明は、このような直線的な スルーレートまたは電流制御に限定されない。他の既知 の回路によって、所望の機能または所望形状を有するス ルーレート、または電流制御を実現することもできる。

【0041】従って、本発明によれば、上述した利点を 満足させるように、スルーレートを制御可能な回路およ び方法が実現できることが明白である。以上、種々の好 適実施例を記述したが、本発明の技術的範囲を逸脱する ことなく、種々の変更、交換等が実行できるものであ る。例えば、本発明を、3相DCモータのステータ巻線 40 中の電流を制御するものについて説明したが、本発明 は、この3相DCモータのみに限定されないものであ る。また、本発明は、FET、即ち、電界効果型トラン ジスタ技術を利用して実施したが、これに限定されるも のでない。また、本発明を、他の技術を使って、例え ば、バイポーラ接合トランジスタ技術を使って、当業者 であれば、実現することができる。

【0042】また、好適実施例で図示説明したような、 別個の回路を組合わせて、1つの回路または、別々の回 路に分割することも、技術的範囲内であれば可能であ

る。更に、上記図示した直接接続を、当業者によれば、 2つのデバイスを、単に、直接接続しないで、中間デバ イスを介して、互いに結合することによって、本発明に よる所望の効果を達成することも可能である。例えば、 図1に示したサンプル増幅器34は、コンデンサスイッ チ20に直結しているが、この代りに、他のデバイス を、技術的思想の範囲内で、これらデバイス間に介在さ せることもできる。また、他の変形例、変更例、交換例 も、以下の請求項によって規定される本発明の技術的思 想および範囲を逸脱することなく、当業者によって容易 に実現することができる。

【0043】以上の説明に関して、更に、以下の項を開 示する。

(1) 多相DCモータのコイルのスルーレートを制御 するに当り、高圧側転流を実行するステップと;第1コ イル中の第1電流および第2コイル中の第2電流を規制 するステップと;これら第1コイルおよび第2コイルは 第1端部と第2端部とを有し、これら第1端部をセンタ ータップに結合し、この第1コイルの第2端部を電流を 20 供給する第1コイル高圧側ドライバに結合し、およびこ の第2コイルの第2端部を、前記電流を規制する第2コ イル低圧側ドライバに結合し;前記第2コイル中の第2 電流を減少させることによって低圧側転流を実行する一 方、これに対応して、第3コイルに第3電流を増加させ るステップと;この第3コイルには、前記センタータッ プに結合された第1端部と、前記第3電流を規制する第 3コイル低圧側ドライバに結合された第2端部とを有 し、この第2電流をゼロへ減少させ、ここで第1電流は この第3電流と等価なものとなり;前記第3電流を規制 転流中に、直線的なスルーレート、または直線的な電流 30 するステップと;前記第1コイルの第1電流を減少させ ることによって高圧側転流を実行する一方、これに対応 して、前記第2コイルの第2電流を増加させるステップ と具備し;前記第2コイルの第2端部を、電流供給用第 2コイル高圧側ドライバに結合し、前記第1電流をゼロ に減少させ、ここでこの第2電流が前記第3電流に等し いものである。コイルのスルーレート制御方法。

> 【0044】(2) 更に、前記第2コイルの第2端部 で発生させた低圧側電圧をサンプリングするステップを 設け、サンプリング電圧を発生させる一方、前記第1お よび第2電流を規制する、第1項記載の方法。

- (3) 更に、前記サンプリング電圧を増大させる一 方、前記低圧側転流ステップを実行するステップを設け た、第2項記載の方法。
- (4) 前記低圧側転流を実行するステップにおいて、 前記第2電流を減少させると共に、前記第3電流を増大 させることを、前記サンプリング電圧を増大させること によって与えられたレートで実行した、第3項記載の方

【0045】(5) 前記サンプリング電圧を、一定の 50 レートで増大させた、第4項記載の方法。

(6) 前記低圧側電圧サンプリングステップに、コン デンサを利用して、この低圧側電圧をサンプリングする 手法を設けた、第4項記載の方法。

15

(7) 前記サンプリング電圧を、電流源から電流を供 給して、前記コンデンサを更に充電することによって増 大させた、第6項記載の方法。

【0046】(8) 前記サンプリング電圧を、前記モ ータ状態に依存した関数に従って増大させた、第6項記 載の方法。

(9) 前記低圧側転流を実行するステップにおいて、 実質的に直線的なレートで、前記第2電流を減少させる と共に、前記第3電流を増大させた、第1項記載の方 法。

(10) 更に、前記第1コイルの第2端部で発生させ た高圧側電圧をサンプリングして、サンプリング電圧を 発生させる一方、前記第1電流および第3電流を規制す るステップを設けた、第1項記載の方法。

【0.047】 (11) 更に、前記サンプリング電圧を 減少させる一方、前記高圧側転流ステップを実行するス テップを設けた、第10項記載の方法。

(12) 前記高圧側転流ステップにおいて、前記サン プリング電圧を減少させることによって得られたレート で、前記第1電流を減少させると共に、第2電流を増大 させた;第11項記載の方法。

【0048】(13) 前記高圧側電圧をサンプリング するステップには、コンデンサを利用して、前記低圧側 電圧をサンプリングする手法を設けた、第12項記載の 方法。

(14) 前記サンプリング電圧を、電流源を利用し て、前記コンデンサを放電させることによって減少させ 30 た、第13項記載の方法。

【0049】(15) 3相DCモータのコイルのスル ーレートを制御するに当り、これらコイルの各々は、第 1端部と第2端部とを有し、各コイルの第1端部をセン タータップに結合する制御回路において、髙圧側転流の 後に、第1コイルと第2コイルを通過する電流を規制す るように作動する第1定常状態制御回路と;この第1コ イルの第2端部を第1の高圧側ドライバに結合すると共 に、この第2コイルの第2端部を第2の低圧側ドライバ ことによって低圧側転流を実行し、これと同時に、第3 コイルを通過する電流を規定されたレートで増大させる ように作動する低圧側転流回路と;およびこの低圧側転 流の後に、前記第1および第3コイルを通過する電流を 規制するように作動する第2定常状態制御回路とを具備 し;この第1コイルの第2端部を前記第1高圧側ドライ バに結合すると共に、この第3コイルの第2端部を第3 低圧側ドライバに結合した3相DCモータのコイルのス ルーレート制御回路。

(16) 更に、前記第1コイルを通る電流を減少させ 50 2端部に与えられた電圧まで充電し、ならびに前記低圧

る一方、これと同時に、前記第2コイルを通る電流を規 定されたレートで増大させることによって高圧側転流を 実行するように作動する高圧側転流回路を設けた、第1 5項記載の回路。

【0050】(17) 前記第1定常状態制御回路に、 前記第2コイルの第2端部に結合したコンデンサを設 け、このコンデンサを、この第2コイルの第2端部に与 えられた電圧まで充電し、および、前記低圧側転流回路 に、前記充電されたコンデンサと、電流源とを設け、こ の電流源によって、このコンデンサを、更に充電する一 方、これと同時に、この電流源によってこのコンデンサ を充電することに関連したレートで第3コイル中の電流 を増大させた、第15項記載の回路。

(18) 前記第2定常状態制御回路に、前記第1コイ ルの第2端部に結合したコンデンサを設け、この第1コ イルの第2端部に与えられた電圧まで、このコンデンサ を充電すると共に、前記高圧側転流回路に、前記充電さ れたコンデンサと、電流源とを設け、この電流源によっ て、このコンデンサを放電させる一方、これと同時に、 この第1コイルの電流を減少させると共に、この電流源 によるコンデンサの放電に関連したレートで、第2コイ ル中の電流を増大させた、第16項記載の回路。

【0051】(19) 多相DCモータのステータコイ ルのスルーレートを制御するに当り、これらステータコ イルの各々は、第1および第2端部を有し、各コイルの 第1端部をセンタータップに結合する制御回路におい て、高圧側転流の後に、高圧側コイルと第1低圧側コイ ルを通過する電流を規制するように作動する第1定常状 熊制御回路と:この高圧側コイルは、高圧側ドライバを 介して電圧源に結合された第2端部を有し、および、こ の第1低圧側コイルは、低圧側ドライバに結合された第 2端部を有し;前記第1低圧側コイルを通る電流を減少 させる一方、これと同時に、予じめ規定されたレート で、第2低圧側コイルを通る電流を増大させることによ って、低圧側転流を実行するように作動する低圧側転流 回路と;この低圧側転流回路は、必要に応じて、追加の 低圧側転流を実行するように作動し;この低圧側転流の 後に、前記高圧側コイルと第2低圧側コイルとを通る電 流を規制するように作動する第2定常状態制御回路と; に結合し;前記第2コイルを通過する電流を減少させる 40 および、前記高圧側コイルの電流を減少させる一方、こ れと同時に、予じめ低圧側コイルとして作用するように 設けた第2高圧側コイルを通る電流を増大させることに よって高圧側転流を実行するように作動する高圧側転流 回路とを具備し、この電流の同時増大および減少を、予 じめ決められたレートで実行したステータコイルのスル ーレート制御回路。

> 【0052】(20) 前記第1定常状態制御回路に、 前記第1低圧側コイルの第2端部に結合したコンデンサ を設け、このコンデンサを、前記第1低圧側コイルの第

側転流回路に、この充電したコンデンサと、電流源とを設け、この電流源によって、このコンデンサを更に充電する一方、これと同時に、前記第1低圧側コイル中の電流を減少させると共に、この電流源によるこのコンデンサの充電に関連したレートで、前記第2低圧側コイルの電流を増大させた、第19項記載の回路。

(21) 多相DCモータのステータコイルにおけるス ルーレートを制御する回路を提供する。この回路には、 第1定常状態制御回路12と、低圧側転流回路60と、 第2定常状態制御回路62と、高圧側転流回路64とが 10 設けられている。この第1定常状態制御回路12によっ て、 高圧側転流の後に、 Aコイル14とCコイル18と を通る電流を規制する。このAコイル14は、その一端 部で、HSDA22を経て電圧源に結合されると共に、 他端部において、センタータップを介してCコイル18 に結合される。このCコイル18は、この状態の下で、 その他端部において、LSDC24に結合される。低圧 側転流回路60は、このCコイル18と、Bコイル16 との電流スルーレートを、このCコイル18の電流がゼ ロに減少すると共に、Bコイル16の電流がゼロから定 20 常状態レベルまで増大するように制御することによっ て、低圧側転流を実行する。このBコイル16を、その 一端部において、センタータップに結合すると共に、他 の端部においてLSDB52に結合する。この第2定常 状態制御回路62によって、低圧側転流の後に、Aコイ ル14と、Bコイル16を通る電流を規制する。高圧側 転流回路64は、Cコイル18とAコイル14との電流 スルーレートを、このAコイル14中の電流がゼロに減

少するようにすると共に、Cコイル18中の電流がゼロから定常状態レベルへ増大するように制御することによって、高圧側転流を実行する。この状態の下で、HSDC66とセンタータップとの間に、このCコイル18を結合させる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明のモータコイルのスルーレート 制御回路で、髙圧側転流の後で得られる第1定常状態制 御回路を示す回路図で、これを第1状態とする。

0 【図2】図2は、同じく低圧側転流回路を示す回路図で、これを第2状態とする。

【図3】図3は、同じく低圧側転流の後で得られる第2 定常状態制御回路を示す回路図で、これを第3状態とする

【図4】図4は、同じく高圧側転流回路を示す回路図で、これを第4状態とする。

【図5】図5は、図1~図4に示した各状態における、 3相DCモータのステータ巻線の各相における制御され たステータ電流を表わすタイミング線図。

0 【符号の説明】

12 第1定常状態制御回路

14, 16, 18 コイル

22, 66 HSDA

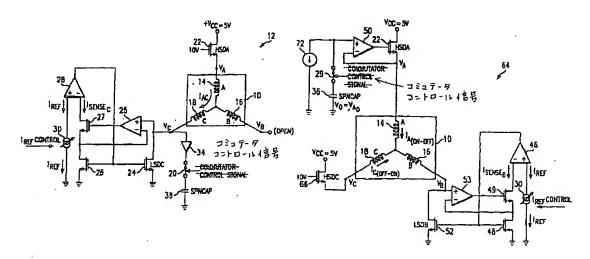
24 LSDC

60 低圧側転流回路

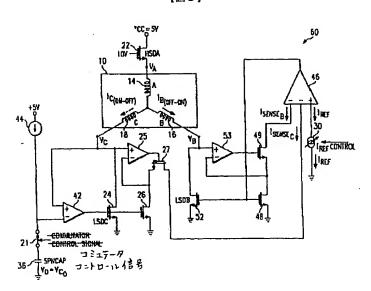
62 第2定常状態制御回路

64 高圧側転流回路

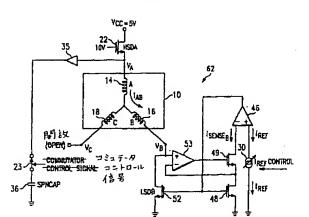
[図1]



【図2】



【図3】



【図5】

